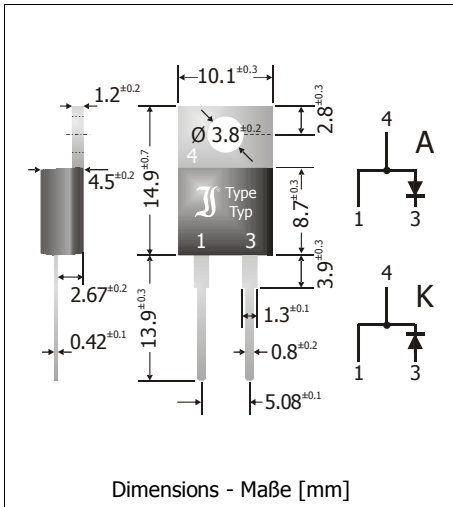


FT2000AA ... FT2000KG
Superfast Silicon Rectifiers – Single Diode / Two Polarities
Superschnelle Silizium-Gleichrichter – Einzeldiode / Zwei Polaritäten

Version 2013-05-07



- Nominal current / Nennstrom 20 A
- Repetitive peak reverse voltage / Periodische Spitzensperrspannung 50...400 V
- Plastic case / Kunststoffgehäuse TO-220AC
- Weight approx. / Gewicht ca. 1.8 g
- Plastic material has UL classification 94V-0 / Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
- Standard packaging in tubes / Standard Lieferform in Stangen



Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Type / Typ		Repet. peak reverse voltage Period. Spitzensperrspanng.	Surge peak reverse volt. Stoßspitzensperrspanng.	Forward voltage Durchlass-Spannung	
Polarity / Polarität		V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]	V_F [V] ¹⁾	
K (Standard)	A (Reverse)			$I_F = 5 A$	$I_F = 20 A$
FT2000KA	FT2000AA	50	50	< 0.84	< 0.96
FT2000KB	FT2000AB	100	100	< 0.84	< 0.96
FT2000KC	FT2000AC	150	150	< 0.84	< 0.96
FT2000KD	FT2000AD	200	200	< 0.84	< 0.96
FT2000KG	FT2000AG	400	400	< 0.84	< 0.96

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ C$	I_{FAV}	20 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 Hz$	I_{FRM}	70 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ C$	I_{FSM}	350/385 A
Rating for fusing, $t < 10 ms$ Grenzlastintegral, $t < 10 ms$	$T_A = 25^\circ C$	i^2t	612 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		T_J	-50...+150°C +200°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	-50...+175°C

1 $T_J = 25^\circ C$

2 Max. temperature of the case $T_C = 100^\circ C$ – Max. Temperatur des Gehäuses $T_C = 100^\circ C$

Characteristics
Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	I_R	< 5 μA typ. 40 μA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 0.5\text{ A}$ through/über $I_R = 1\text{ A}$ to $I_R = 0.25\text{ A}$	t_{rr}	< 200 ns
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thc}	< 1.5 K/W

